مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۴، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۳

ڒۅۿۺ؋ۑڔڹۣڮ

بهبود حسگری گاز هیدروژن لایههای اکسید تنگستن با استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره

رقيه قاسمپور و اعظم ايرجىزاد

۱. دانشکدهٔ علوم و فنون نوین، گروه انرژیهای نو و محیط زیست دانشگاه تهران ۲. دانشکدهٔ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف ghasempour.r@ut.ac.ir پست الکترونیکی:

(دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲۶ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۳/۱/۱۶)

چکیدہ

لایههای هیبریدی متشکل از Wor / WWNTs به روش چرخشی بر روی زیر لایهٔ آلومینا لایهنشانی شدند. مورفولوژی، ترکیبات شیمیایی، ساختار بلوری، کیفیت مواد و اندازه نانوذرات اکسید تنگستن، نانولولههای کربنی و لایههای حساس هیبریدی با استفاده از آنالیزهای TEM باختار بلوری، کیفیت مواد و اندازه نانوذرات اکسید تنگستن، نانولولههای کربنی و لایههای حساس هیبریدی با استفاده از آنالیزهای TEM عامل دار ایجاد شدهاند. این عاملهای اکسیژنی سبب پخش شدگی نانولولهها در یاخته حاوی نانوذرات اکسید تنگستن و شکل گیری نانوذرات عامل دار ایجاد شدهاند. این عاملهای اکسیژنی سبب پخش شدگی نانولولهها در یاخته حاوی نانوذرات اکسید تنگستن و شکل گیری نانوذرات برسطح نانولولهها میشود. در نتیجه، پوشش کاملی از ذرات اکسید تنگستن بر سطح نانولولههای کربنی ایجاد میشود. بعد از لایهنانی و پخت لایهها در دمای ۲۵۰۵۳ پاسخ لایههای هیبریدی نسبت به گاز هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفت. افزودن مقادیر کمتر از ۵۰۰٫ درصـد وزنی از نانولولههای کربنی نسبت به تنگستن، سبب بهبود خواص حسگری لایههای هیبریدی میشود بهطوری که با افزودن مقدار ۳۰۰٫ گاز هیدروژن به دست آمد. علاوه بر این، نتاج نشان می دهد حد شناسایی این ساختارها به گاز هیدروژن به سو ۱۰ میرسد. با افزودن نانولولههای کربنی، دمای کار از ک⁰۰۰۰ در لایههای اکسید تنگستن خالص در پاسخ به غلظت mp ۱۰۰۰ گاز هیدروژن به دست آمد. علاوه بر این، نتاج نشان می دهد حد شناسایی این ساختارها به گاز هیدروژن به mo ۱۰ می رسد. با افزودن نانولولههای کربنی، دمای کار از ک⁰۰۰۰ در لایههای اکسید تنگستن خالص به کان در لایههای هیبریدی کاهش یافت. افزایش پاسخ لایههای هیبریدی نتیجهٔ افزایش سطح مؤثر و تعداد سد پتانسیلهای حساس به گاز در محل اتصال نانوذرات اکسید تنگستن به یک رود

واژەھاي كليدى: حسگرھاي ھيبريدى گاز، حسگرھاي گاز ھيدروژن، نانولولەھاي كربنى

۱. مقدمه

است. استنشاق مقدار بسیار کم برخی از گازهای سمی، آلوده کننده یا کارکردن درمحیط گازهای اشتعالزا از مواردی هستند که همواره سلامتی انسان را تهدید مینمایند. از این رو شناسایی، اندازهگیری و کنترل گازها در محیطهای کار و

امروزه تأثیر صنایع مختلف بر ارتقاء سطح رفاه و کیفیت زندگی بشر غیر قابل انکار است، اما متأسفانه با پیشرفت صنایع، آلودگی های زیست محیطی سلامت انسان را به مخاطره افکنده

آزمایشگاه ها ضروری است. گاز هیدروژن یکی از گازهای بیرنگ و بیبو است که در غلظت های بالای ۴ درصد خاصیت انفجاری دارد. این گاز کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف مانند صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، شیمیایی، الکترونیکی، پزشکی و به ویژه در صنایع خودروسازی دارد [۱-۳]. استفاده از این گاز به عنوان سوخت پاک یکی از بهترین جایگزین های سوخت فسیلی در خودروها مطرح است. لذا در صنایع انرژی های نو و تجدیدپذیر توجه بسیاری به صنعت هیدروژن شده است [۳]. بنابراین ضرورت استفاده از حسگرهای دقیق در کلیهٔ مراحل تولید، انتقال و ذخیرهسازی هیدروژن کاملاً محسوس می باشد.

امروزه بیـشتر حـسگرها از اكـسیدهای فلـزی نـیمرسـانایی تشکیل شدهاند که تغییرات کمیات فیزیکی و شیمیایی سطح آنها به یک سیگنال قابل اندازهگیری تبدیل میشود [۴–۷]. ب پیشرفت صنایع الکترونیک و ساخت دستگاههای دقیق در ثبت دادهها، رویکرد صنعت به سمت اندازهگیری سیگنال الکتریکی روز به روز بیشتر شـده اسـت. از ایـزرو، عملکـرد بـسیاری از حـسگرهای موجـود بـر پایـهٔ انـدازهگیـری تغییـرات خـواص الکتریکی استوار است. بهکارگیری نانوساختارهای اکسیدهای فلزی، به دلیل بهره گیری از سطح مؤثر بالا، سبب بهبود خواص حسگری آنها شده است [۸-۱۰]. اما برخی از معایب استفاده از این حسگرها هنوز موضوع چالشهای علمی دانشمندان است. یکی از معایب حسگرهای نیمرسانا، دمای کار بالای آنها میباشد. دمای کار بالا، علاوه بر مصرف انرژی زیاد، به دلیل نفوذ اکسیژن از درون لایه به سطح، طول عمر حـسگر را کوتـاه میکند [۱۱ و ۱۲]. برای رفع این مشکل، استفاده از مواد جدیدی مانند نانولولههای کربنی مورد توجه قرار گرفته است. نانولولههای کربنی که به بسیاری از گازها حساس میباشند، می توانند پایهٔ یک حسگر گاز را تشکیل دهند یا با سایر مواد در حسگری گاز مشارکت داشته باشند. سـاختارهای کـامپوزیتی و هیبریدی از جمله ساختارهایی هستند که نانولولههای کربنی در آنها نقش بسزایی در بهبود عملکرد آنها دارد [۱۳-۲۰]. هدف این تحقیق، استفاده از نانولولههای کربنی چند دیواره در

لایههای هیبریدی به منظور کاهش دمای کار حسگر گاز هیدروژن میباشد. در این مقاله، از لایههای حساس بر پایهٔ نانوساختارهای هیبریدی متشکل از نانولولههای کربنی و نانوذرات اکسید تنگستن برای حسگری گاز هیدروژن استفاده شده است و پس از ساخت و مشخصهیابی لایههای حساس، به مطالعهٔ تأثیر حضور نانولولههای کربنی بر خواص حسگر گاز هیدروژن بر اساس تغییرات خواص الکتریکی لایههای نازک هیبریدی، پرداخته شده است. در انتها، مکانیزم حسگری بر پایهٔ مدل سادهای بیان شده است.

۲. روشهای آزمایش بر ربته بر بر

۲. ۱. آمادهسازی سوسپانسیون و لایهٔ هیبریدی

نانولولههای چند دیوارهٔ بهکاربرده شده در این مقاله از شرکت نانوتایم ^۱ خریداری شدهاند. این نانولولهها به روش نشست بخار شیمیایی^۲ (CVD) رشد داده شدهاند. به منظور خالص سازی و عامل دار نمودن سطح نانولوله ها، از روش اکسایش در محیط نیتریک اسید و هیدروکلریدریک اسید ۵ مولار به ترتیب در دمای ۲°۸۰ به مدت ۱۲ ساعت و ۲°۲۰ به مدت ۶ ساعت استفاده شده است. پس از فیلتر کردن و شستشو با آب دیونیزه، نانولوله های کربنی در دمای اتاق خشک شدند.

بهطور جداگانه، نانوذرات اکسید تنگستن به روش کودو و از مادهٔ اصلی پراکسو پلی تنگستیک اسید از انحلال قطعات ریز تنگستن در آب اکسیژنه ۳۷٪ در دمای اتاق بهدست آمد [۲۱].

برای ساخت سوسپانسیون هیبریدی، پس از آمادهسازی یاختهٔ اولیهٔ حاوی نانوذرات اکسید تنگستن و پودر نانولولههای عامل دار، این دو ماده در دمای اتاق به مدت ۴۸ ساعت با مقادیر نسبت وزنی ۵۰۰۰۰ – ۰۱۰۰۰۰ (MWNTs با یکدیگر مخلوط گردیدند. سپس یاختهٔ حاوی نانوذرات اکسید تنگستن و سوسپانسیون هیبریدی برروی زیر لایهٔ آلومینا لایهنشانی گردیدند. برای تهیهٔ لایههای حساس از روش لایهنشانی چرخشی استفاده شد. پس از لایهنشانی، نمونهها در دمای ۲۵۰۰۳ ب

^{1.} Nanotime

۲. Chemical Vapor Deposition



شکل ۱. به طور نمادین مراحل ساخت لایههای نازک هیبریدی را نشان میدهد.

مدت یک ساعت پخت شدند. دولایهای طلا / تیتانیم با استفاده از الگوی شانهای بر روی نمونه لایهنشانی گردید. به منظور بالابردن پایداری حرارتی، پس از لایهنشانی طلا، نمونه ها تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. پس از این مرحله، با استفاده از اتصال سیم های نازک مسی به لایهٔ طلا، جریان و یا مقاومت نمونه اندازه گیری گردید.

۳. روش آزمایش و دستگاهها

در این مقاله معیار ارزیابی پاسخ نمونهها، تغییرات جریان الکتریکی در لایههای حساس تعریف گردیده است. با اندازه گیری پیوستهٔ تغیرات جریان نمونه در تمامی مراحل عبور گاز و قطع گاز، پاسخ نمونه محاسبه می شود. پاسخ نمونهها از رابطهٔ $\frac{I_{gas}}{I_{air}}$ به دست می آید که در آن I_{gas} و I_{ai} به ترتیب جریانهای اندازه گیری شدهٔ نمونه در معرض گاز هیدروژن و هوای خشک می باشد. شار گاز هیدروژن و هوای خشک توسط کنترل کننده شار کنترل می شود و جریان نمونه توسط آمپرمتر متصل به کامپیوتر Sanowa با نرم افزار Mil OP اندازه گیری و ثبت می گرد. در نگهدارندهٔ نمونه، برای هر نمونه، گرمکنی تعبیه شده است که قادر است در صورت نیاز، دمای نمونه را افزایش

برای مشاهدهٔ سطح نانولولههای عامل دار شده، از میکروسکوپ الکترونی عبوری^۲ مدل LEO 912AB و مدل Philips XL30 استفاده شده است و همین طور برای ریخت شناسی سطوح لایههای نازک ساختارهای هیبریدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی^۳

- Y. Transmission Electron Microscopy (TEM)
- Scanning Electron Microscopy (SEM)

LEO 1455VP استفاده گردیده است.

میزان ساختار منظم و معیوب نانولوله های کربنی خالص، عامل دار شده و ساختارهای هیبریدی با استفاده از طیف سنجی رامان مدل (Microprobe (HR – 800 Jobin – Yvon) با لیزر Nd-YAG با طول موج ۵۳۲ نانومترکار میکند، مورد بررسی قرار گرفتند.

از دستگاه Molvern, zetasizer Nano-Smodel ZEN1600 از دستگاه برای تعیین اندازهٔ ذرات اکسید تنگستن در درون یافته استفاده شده است. اندازهٔ این ذرات با استفاده از پراکندگی نور لیزر قرمز رنگ با طول موج ۶۳۳ نانومتر به دست آمده است.

در این تحقیق، ساختار بلوری لایههای اکسید تنگسن و هیبریدی با استفاده از طیف سنج پراش اشعه X X 40 mA م Philips X'pert Cu K_a (λ = 1/54 Å) X-ray diffractometer تعیین گردیده است.

برای انجام آزمایش طیفسنجی فوتوالکترونهای اشعهٔ، X از یک منبع اشعهٔ X با آند Al-Mg (Al-Mg anode, EA10 plus) و یک تحلیل گر نیم کروی متحدالمرکز در محفظهای با فشار پایهٔ torr ^۹ ۱۰ استفاده شده است.

۴. بحث و بررسی نتیجهٔ آزمایشها

شکل ۱ تصویر TEM از نانولوله های کربنی قبل و بعد از عامل دار شدن را نشان می دهد. همان طور که در شکل ۱ دیده می شود، محیط اسیدی سبب از بین رفتن فیبرها و ذرات کربن آمورف گردیده است. علاوه بر این سبب بروز عیوب سطحی بر سطح نانولوله ها نیز می شود. شکل ۱ (ب) سطح نانولوله ها و عیوب سطحی آن را با بزرگنمایی بیشتر نشان می دهد.

^{1.} Mass Flow Controller (MFC)



شکل ۱. تصویر TEM از نانولولههای کربنی (الف) قبل و (ب) بعد از عامل دار شدن.



شکل ۲. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) طیف رامان پودر نانولولههای کربنی قبل و بعد از عاملدارشدن.

به منظور بررسی ساختارهای معیوب در پودر نانولوله های خالص و عامل دار، از آنالیز رامان استفاده شد. شکل ۲ طیف رامان پودر نانولوله های کربنی را نشان می دهد. قله های موجود در ⁻¹ ۱۵۸۳ معرف ارتعاشات حاصل از پیوند C-C (Gbad) و ⁻¹ تعییر شکل معرف وجود ساختارهای معیوب ناشی از ⁻¹ تغییر شکل، انحنا و شکستگی پیوند کربن -کربن می باشد. نسبت از از از می است. در این رابطه تغییر شکل، انحنا و شکست می بوند کربن می باشد. نسبت از از از می اندان دهنده کیفیت نانولوله های کربنی است. در این رابطه از از از می از می باشد. همان از منان دهنده کیفیت نانولوله های کربنی است. در این رابطه نوع نانولولهٔ کربنی مساوی یک می باشد. بنابراین انتظار می رود با حذف ساختارهای معیوب مانند کربن های آمورف و فیبرها این

نسبت افزایش یابد ولی با افزایش عیوب سطحی نانولولهها که توسط تصویر TEM نیز تأیید میشود، شدت قله D-band افزایش یافته و نسبت ذکر شده در بالا به یک میرسد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت، فرآیند عاملدار نمودن سبب ایجاد عیوب در نانولولههای کربنی میشود.

همان طور که در بخش آمادهسازی اشاره گردید، با استفاده از روش کودو، نانوذرات اکسید تنگستیک اسید در یاختهٔ اولیه به وجود آمدند. شکل ۳ از راست به ترتیب طیف SLG و XRD حاصل از یاختهٔ اولیهٔ اکسید تنگستن را نشان میدهد. این نانوذرات اکسید تنگستن آمورف ، آبدار و به شکل WOr.TH_TO با اندازهٔ تقریبی ۱۴ نانومتر در درون یاخته پراکنده شدهاند.

به منظور تهیهٔ سوسپانسیون هیبریدی، مقادیر متفاوتی از پودر نانولولههای کربنی به یاختهٔ اکسید تنگستن افزوده شد. شکل ۴ طیف Uv.Vis سوسپانسیون هیبریدی را نشان میدهد. لبهٔ جذب ذرات اکسید تنگستن در سوسپانسیون هیبریدی به طول موج بیشتر انتقال یافته و انرژی شکاف آن نیز از ۲۰ ۲/۸۲ به ۲/۷۵ eV رسیده است که گویای بزرگتر شدن زرات میباشد. بنابراین ذرات موجود در یاخته به یکدیگر چسبیده و خوشههای اکسیدی تشکیل میدهند.

به منظور شناسایی ترکیب شیمیایی سطح نانولولههای کربنی و و ساختار هیبریدی از آنالیز XPS استفاده شد. شکل ۵ طیـف





شکل ۴. طيف Uv.Vis سوسپانسيون هيبريدي.

XPS پودر نانولولههای عاملدار شده و هیبریدی رانشان میدهد. حضور قله اکسیژن در شکل ۵ (الف) گویای تشکیل گروههای عاملی اکسیژنی بر سطح نانولولههای کربنی میباشد. این گروههای عاملی علاوه بر افزایش پخش شدگی نانولولهها در یاختهٔ حاوی نانوذرات اکسید تنگستن، سبب شکل گیری نانوذرات اکسید تنگستن بر سطح نانولولهها نیز میشود. با مقایسهٔ شکلهای ۵ (الف) و (ب)، افزایش شدت قلهٔ اکسیژن و کاهش شدت قلهٔ کربن قابل تشخیص میباشد. علاوه بر این، حضور قلهٔ تنگستن نیز حاکی از تشکیل ترکیباتی از تنگستن بر روی سطح نانولولهها میباشد. شدت قلهٔ کربن در پودر هیبریدی کمتر از نانولولههای عاملدار است. این کاهش



Binding Energy (ev) شکل ۵ طیف کلی XPS از پودر نانولولههای عامل دار (الف) و پودر هیبریـدی (ب).

تنگستن می باشد که سبب کاهش تعداد فوت والکترون های ساطع شده از کربن گردیده است. از طرف دیگر میزان اکسیژن در سطح پودر هیبریدی بیش از نانولوله های عامل دار می باشد. این تفاوت ناشی از سهم اکسیژن های اکسید تنگستن موجود در سطح نانولوله ها علاوه بر اکسیژن های موجود بر سطح نانولوله های عامل دار می باشد.

نکتهای که مورد سؤال قرار می گیرد این است که آیا با نشستن نانوذرات اکسید تنگستن برسطح نانولولهها، تعداد عیوب ساختاری نانولولهها کاهش پیدا می کند؟ پاسخ این سؤال را می توان در طیف رامان جستجو کرد. لذا از پودر هیبریدی، طیف رامان تهیه گردید. شکل ۶ طیف رامان نانولولههای عاملدار شده و پودر هیبریدی را نشان می دهد.



شکل ۶. طیف رامان پودر نانولولههای عاملدار شده (الف) و پودر هیبریدی (ب).



شکل ۸. مقاومت نمونه های هیبریدی برحسب مقدار نانولوله.

همان طور که در شکل ۶ دیده می شود نسبت I_G/I_D در هردو طیف یک می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت، مخلوط شدن یاختهٔ حاوی نانوذرات با پودر نانولوله های عامل دار شده، بر تعداد عیوب ساختاری نمی افزاید و فقط سبب تماس بیشتر و یکنواخت دو ماده و ایجاد پوشش بر سطح نانولوله ها می شود.

پس از تهیه سوسپانسیون هیبریدی، آن را بر روی زیر لایهٔ آلومینای آبدوست شده لایهنشانی میشود و سپس تحت عملیات حرارتی در دمای ۲۵۰°C پخت میشود. شکل ۷ تصویر SEM از لایهٔ هیبریدی ۳۵۰۳۷ را نشان میدهد.

همان طور که در شکل دیده می شود نانولولههای پوشیده شده از لایهای از اکسید تنگستن در درون لایهٔ اکسیدتنگستن مدفون شدهاند و سطح لایه از نانوذرات اکسید تنگستن تـ شکیل شده است. حضور نانولولهها در درون فضای ترکها مانند یک

پل رسانا عمل کنند. این مسئله به کاهش مقاومت اولیهٔ لایه بسیار کمک می کند. شکل ۸ مقاومت نمونه های هیبریدی را بر حسب مقدار نانولوله در ساختار نشان می دهد. همان طور که در شکل ۸ مشاهده می شود، با افزایش مقدار نانولوله ها در لایه و در درون ترکها، انتقال الکترونی در درون لایه افزایش یافته و مقاومت لایه کاهش می یابد. علاوه براین، حضور نانولوله ها به عنوان یک ماده حساس به گاز، بر خواص حسگری لایه های هیبریدی نیز تأثیر گذار است.

۵. بررسی خواص حسگری گاز هیدروژن

پس از آمادهسازی لایههای نازک هیبریدی اکسید تنگستن و نانولولههای کربنی، پاسخ آنها به گاز هیدروژن به روش دینامیکی اندازه گیری شد. شکل ۹ نمونهای از رفتار لایههای هیبریدی در دمای ۲°۳۲۰ نسبت گاز هیدروژن با غلظتهای متفاوت را نشان میدهد.

همان طورکه در شکل ۹ مشاهده می شود، با ورود گاز هیدروژن به درون محفظه، جریان الکتریکی لایه افزایش می یابد و در مدت زمان کوتاه، حدود چند ثانیه، به حالت اشباع می رسد. پس از قطع شارش گاز هیدروژن، جریان الکتریکی نمونه سریع به حالت اولیهٔ خود باز می گردد. شکل ۱۰ مقایسه ای بین پاسخ لایه های اکسید تنگستن خالص و هیبریدی در دمای کار 2°°۰۰ و نسبت به غلظتهای مختلف گاز هیدروژن را نشان می دهد. همان طورکه در شکل ۱۰ مشاهده می شود، نمونه های



شکل ۷. تصویر SEM از لایه هیبریدی MWNTs/WO۳.



شکل ۹. نمونهای از رفتار لایههای هیبریدی در دمای C° ۳۲۰ نسبت به هیدروژن با غلظتهای متفاوت.



سس ۲۰۰ پاست نمونه میبریدی ۲۰۰ – ۲۰۵۰ (۱۹۹۱، ۱۹۷۱، ۱۹۷۱) و ۲۰۰۴ محصل ۲۹۰، ب مطلب کی محمد کار میدروری در دخانی C°۰۰°C، شکل سمت چپ پاسخ نمونهٔ در غلظتهای پایین با بزرگنمایی بیشتر.

نسبت به گاز، بر دمای کار حسگر نیز تأثیر گذار است. شکل ۱۱ پاسخ نمونههای هیبریدی با غلظتهای متفاوت از نانولولههای کربنیی را در دماهای مختلف نشان میدهد.

با توجه به اینکه دمای کار نمونههای خالص که در حدود ۴۰۰°C تا ۲۵°۴۵ است [۲۱]، دو نکتهٔ بسیار مهم از شکل ۱۱ قابل استنتاج میباشد.

اول اینکه، همان طور که در شکل ۱۱ دیـده مـیشـود، افـزودن مقادیر کمی از نانولوله می تواند دمای کار نمونه را کاهش دهـد. علاوه براین، دمای بهینه به غلظت نانولولـهها در لایـه بـستگی دارد. بـا کـاهش غلظـت نانولولـهها، از نـسبت وزنـی ۵۰ °۰۰ هیبریدی در غلظت ۱۲۰۰۰ مقربیاً ۲۰ برابر، پاسخ بهتری نسبت به نمونه های خالص دارند. این افزایش در تمامی غلظت های گاز دیده می شود. نکتهٔ جالبی که در شکل وجود دارد، روند کند و اشباع آن در غلظت های بالای ppm افزایش غلظت گاز پاسخ آن نیز افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج نشان می دهد آستانهٔ شناسایی در نمونه های هیبریدی به ppm ۱۰ می رسد. بنابراین برای شناسایی و تعیین غلظت گاز هیدروژن نمونه های هیبریدی مناسبی می است. می باشند.

حضور نانولولههای کربنی علاوه بر افزایش پاسخ نمونه



شکل ۱۱. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) پاسخ نمونههای هیبریـدی بـا غلظتهای متفاوت از نانولولـه در دماهـای کـار مختلـف نـسبت بـه غلظت گاز هیدروژن ۱٪.

دمای کار بهینهٔ نمونه از C°۰۰° کاهش یافته و به C°۲۰۰ میرسد. بنابراین با افزودن مقادیر کمی از نانولولهٔ کربنی (کمتر از ۵۰۰/۰ وزنی) دمای کار لایه بدون استفاده از هرگونه کاتالیستی کاهش مییابد.

دوم این که، با افزایش غلظت نانولولهها و نسبت وزنی در لایه، پاسخ نمونه نیز به گاز هیدروژن افزایش پیدا میکند. بهطوری که در نسبت وزنی ۵۳،۰٫۰ این افزایش به ۵۰ برابر لایههای اکسید تنگستن خالص میرسد. اما در نسبت وزنی ۵۰۰٫۰ کاهش پاسخ نمونه مشاهده میشود. این کاهش پاسخ ناشی از افزایش رفتار نیمهرسانایی نوع q در لایه و بهم چسبیدگی و تشکیل دستههای نانولولههای کربنی در لایه میباشد. این امر سبب کاهش پراکندگی نانولولهها در لایه می باشد. این امر که در بخش سازوکار اشاره خواهد شد، تعداد سد پتانسیل های متأثر از گاز کاهش مییابد. بنابراین نباید از نانولولهای کربنی بیش از ۵۰۰٫۰ وزنی استفاده نمود.

۶. بررسی سازوکار حسگری گاز هیدروژن

سازوکار حسگری به طور طرحوار در شکل ۱۲ نشان داده شده است. در درون لایههای هیبریدی دو نوع سد پتانسیل وجود دارد: اول، بین ذرات اکسید تنگستن با یکدیگر در درون زمینهٔ



شکل ۱۲. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) طرحوار تغییر سد پتانسیل در فصل مشترک نانو ذرات و نانولولهها (الف) قبل (ب) بعد از شارش گاز هیدروژن برسطح نمونه دایرههای سبز (دایرههای بـزرگ) معـرف اکسیژن و زرد (دایرههای کوچک) معرف هیدروژن.

اکسیدی که غالب لایه را تشکیل میدهند. همین طور بین دانههای پوشش یافتهٔ سطحی نانولولهها با یکدیگر و با دانههای زمینهٔ اکسیدی. دوم، بین ذرات اکسید تنگستن نشسته بر سطح نانولولهها و خود نانولولههای کربنی.

سد پتانسیل های بیان شده در بالا، در شکل ۱۲ نـشان داده شده است. با شارش گاز هیدروژن بر سطح لایـه، مولکـولهـای هیدروژن با اکسیژنهای جذب شده واکنش داده و آب تـشکیل مىدهد. با جذب اكسيژن و واجذب آب از سطح، الكترون، اي به دام افتاده توسط اکسیژن به ساختار باز گردانده می شوند. ایس انتقال بار سبب کاهش ارتفاع سد پتاسیل ها شده و عبور الکترون از لایه تسهیل میشود (شکل ۱۲ (ب)). بـا قطع شـارش گـاز هیدروژن و جای گیری مولکول های اکسیژن در مراکز فعال سطح، به دلیل آزاد شدن این مراکز به سبب واجذب مولکول های آب، سطح لايه به سرعت به شرايط اوليهٔ خود باز مي گردد. بنابراين به دلیل مشارکت نانولولهها، تعداد سد پتانسیلها بین نانولولـههـا و ذرات افزایش می یابد و این امر سبب افزایش پاسخ نمونه می شود. علاوه بر این، وجود حفرهها، مسیر رسیدن مولکول های ریز هیدروژن به اعماق لایـه را ایجـاد مـیکننـد. در نتیجـه نفـوذ پذیری گاز در لایه افزایش پیدا میکند. این امر سبب افزایش سطح واکنش و پاسخ نمونههای هیبریدی میشود.

۶. نتيجه گيرې

در این تحقیق، ساختار لایههای هیبریدی حساس MWNTs / WOr با مقادیر متفاوتی از نانولولههای کربنی به منظور بررسی خواص حسگری نسبت به گاز هیدروژن ساخته شد. مورفولوژی و ترکیبات شیمیایی، ساختار بلوری و کیفیت نانولولههای کربنی عاملدار، نانوذرات اکسید تنگستن و لایههای حساس هیبریدی با آنالیزهای Raman, XRD, SEM, TEM رود.

نتیجهٔ آنالیزها نشان دادند که روی سطح نانولولههای عامل دار شده با گروههای عاملی اکسیژنی فعال می شود. بدین ترتیب، پوشش کاملی از نانوذرات اکسید تنگستن بر سطح نانولولهها ایجاد می شود. بعد از لایه نشانی و پخت لایهها، نانولولههای کربنی پوشیده شده با نانوذرات اکسید تنگستن در

- مراجع
- J ckermann, P R Krafft, L Shoemaker, R E Lieberson, S D Chang, and A Colohan, *Medical Gas Res.* 2 (2012) 11.
- T Lipman, "An Overview of Hydrogen Production and Storage Systems with Renewable hydrogen Case Studies", US DOE Grant DE-FC3608GO18111 A000 (2011).
- L M Gandía, G Arzamendi, and P M Diéguez, *"Renewable Hydrogen Energy: An Overview"*, Renewable Hydro. Tech. (2013).
- J Tamaki, C Naruo, Y Yamamoto, and M Matsuka, Sensors and Actuators B 83 (2002) 190.
- M Ivanovskaya, D Kotsikau, G Faglia, P Nelli, and S Irkaev, Sensors and Actuators B 93 (2003) 422.
- F Paraguay, D M Miki-Yoshida, J Morales, J Solis, W Estrada L, *Thin Solid Films* 373 (2000) 137.
- T Miyata, T Hikosaka, and T Minami, Sensors and Actuators B 69 (2000) 16.
- S Yu, U Welp, L Z Hua, A Rydh, W K Kwok, and H Hau Wang, *Chem. Mater.* 17 (2005) 3445.
- M Epifani, A Helwig, J Arbiol, R D'1az, L Francioso, P Siciliano, G Mueller, and J R Morante, *Sensors and Actuators* B 130 (2008) 599.
- 10. G J Cadena, J Riu, and F X Rius, Analyst, 132 (2007)1083

درون لایهٔ اکسید تنگستن قرار گرفته و سبب ایجاد پل الکتریکی بین دو لبهٔ ترکهای لایه میشوند و مسیر انتقال الکترون را فراهم میسازند. پاسخ لایههای هیبریدی نسبت به هیدروژن بیشتر از لایههای اکسید تنگستن خالص میباشد. با افزودن نانولوله با مقادیر کمتر از ۵۰۰٬۰ وزنی، علاوه بر افزایش قابل توجه پاسخ لایهٔ حسگر، دمای کار آن از ۲۰۰۰ در نمونههای اکسید تنگستن خالص به ۲۰۰۰ در ساختارهیبریدی کاهش مییابد. افزایش پاسخ در ساختار هیبریدی ناشی از افزایش سطح مؤثر و تعداد سد پتانسیلهای حساس به گاز در محل اتصال نانوذرات اکسید تنگستن به یکدیگر و همین طور با مقدار نانولوله های کربنی میباشد. تعداد سد پتانسیل ایجاد شده به مقدار نانولوله بستگی دارد. مقادیر بیش از ۵۰٬۰ وزنی سبب

- N Yamazoe, J Fuchigamii, M kishikawa, and T Seiyama, Surf. Sci. 86 (1979) 335.
- 12. J F McAleer, P T Moseley, J O W Norris, and D E William, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1 (1987) 1323.
- U Schlecht, K Balasubramanian, M Burghard, and K Kern, *Appl. Surf. Sci.* 253-20 (2007) 8394.
- 14. A Kaniyoor and S Ramaprabhu, *Carbon* **49** (2011) 227.
- 15. L Berry and A Hamwi, Sens. Act. B-Chem. 150-2 (2010) 700.
- 16. D Ding, Z Chen, S Rajaputra, and V Singh, Sens. Actu. B-Chem. 124 (2007) 12.
- C Wongchoosuk, A Wisitsoraat, D Phokharatkul, A Tuantranont, and T Kerdcharoen, *Sensors* 10 (2010) 7705.
- 18. S Yousefzadeh, A Reyhani, N Naseri, and A Z Moshfegh, J. Solid Stat. Chem. 204 (2013) 341.
- J S Oakley, H T Wang, B S Kang, Z Wu, F Ren, A G Rinzler, and S J Pearton, *Nanotechnology* 16 (2005) 2218.
- 20. I Sayago et. al., Sens. Act. B-Chem. 122 (2007) 75.
- 21. S Fardindoost, A Irajizad, F Rahimi, and R Ghasempour, *International Journal of Hydrogen Energy* 35, 2 (2010) 854.